

Information



SU 189, SU 190

1/84

Vorläufige technische Daten

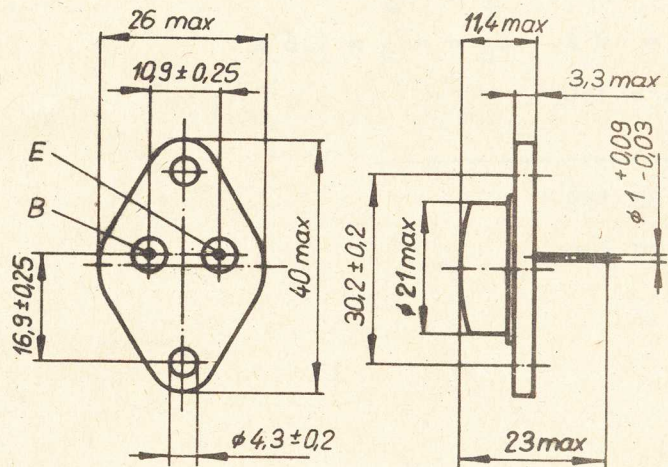
Hersteller: VEB Mikroelektronik "Karl Liebknecht" Stahnsdorf

Si-npn-Leistungsschalttransistor für Schaltnetzteile und Motorsteuerung

Maße in mm und Anschlußbelegung

Masse ca. 22 g

Kollektor am Gehäuse



Grenzwerte, gültig für den Betriebstemperaturbereich

		SU 189	SU 190
Kollektor-Basis-Spannung $I_E = 0$	U_{CBO}	850	1000 V
Kollektor-Emitter-Spannung $I_B = 0$	U_{CEO}	400	450 V
Kollektorstrom	I_C	15	A
Kollektorspitzenstrom	I_{CM}	30	A
Gesamtverlustleistung $\vartheta_c = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	175	W
Sperrschichttemperatur	ϑ_j	200	$^\circ\text{C}$

Kennwerte, bei $J_c = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		min.	max
Kollektor-Emitter-Reststrom $U_{CE} = 850 \text{ V}, R_{BE} \leq 10 \Omega$ 1)	I_{CER}		1,0 mA
$U_{CE} = 1000 \text{ V}, R_{BE} \leq 10 \Omega$ 2)			
Kollektor-Emitter-Sättigungs- spannung	U_{CESat}		1,5 V
$I_C = 10 \text{ A}, I_B = 2 \text{ A}$ 1)			
$I_C = 8 \text{ A}, I_B = 1,6 \text{ A}$ 2)			
Basis-Emitter-Sättigungs- spannung	U_{BESat}		1,6 V
$I_C = 10 \text{ A}, I_B = 2 \text{ A}$ 1)			
$I_C = 8 \text{ A}, I_B = 1,6 \text{ A}$ 2)			
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung	$U_{(BR)CEO}$	400 ¹⁾ 450 ²⁾	V V
$I_C = 0,2 \text{ A}$			
Emitter-Basis-Durchbruchspannung	$U_{(BR)EBO}$	10	V
$I_E = 0,01 \text{ A}$			
Abfallzeit des Kollektorstromes	t_f		0,8 μs
$I_C = 10 \text{ A}, I_B = -I_B = 2 \text{ A}$ 1)			
$I_C = 8 \text{ A}, I_B = -I_B = 1,6 \text{ A}$ 2)			
$U_{CC} = 150 \text{ V}$			

1) SU 189

2) SU 190

BE-Nr. SU 189: 137 82 14 106 189071
SU 190: 137 82 13 103 190080

Die vorliegenden Datenblätter dienen ausschließlich der Information! Es können daraus keine Liefermöglichkeiten oder Produktionsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten.

RFT

Herausgeber:
vab applikationszentrum elektronik berlin
im vab kombinat mikroelektronik

DDR-1035 Berlin, Mainzer Straße 25
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981 011 3055